PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-074898

(43)Date of publication of application: 10.03.1992

(51)Int.CI. C25D 21/14

C25D 3/38 C25D 7/12 **BEST AVAILABLE COPY**

(21)Application number: 02-184990

(71)Applicant:

PERMELEC ELECTRODE LTD

ARUMETSUKUSU:KK

(22)Date of filing:

12.07.1990

(72)Inventor:

UENO KENICHI HIRAO KAZUHIRO

YAMAKAWA YOSHINAGA

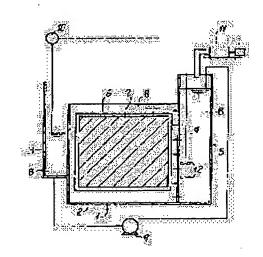
ICHIKAWA KIYOSHI

(54) COPPER PLATING DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To rapidly replenish a dissolved copper compd. into a plating cell by disposing the plating cell and a dissolving cell for dissolving the copper compd. into the plating liquid circulated from the plating cell adjacent to each other.

CONSTITUTION: The device body 1 consists of the box type plating cell 2 in the central part, an overflow cell 3 installed integrally to the left side wall of this plating cell 2 and the dissolving cell 5 integrated with the plating cell 2 via a diaphragm 4 which does not permeate the undissolved solid copper compd. and allows the permeation of only the plating liquid on the right side of the plating cell 2. The concn. of the copper ions in the plating liquid 8 decreases on continuation of the plating operation. The concn. of the copper ions is measured by a concn. sensor 10. The solid copper compd. is supplied into the dissolving cell 5 by operating a copper compd. feeding—out device 11 when the measured concn. falls down to the prescribed value or below. This copper compd. is dissolved into the plating liquid 9 in the dissolving cell 5 by a stirring vane 12. The plating liquid is supplied through the diaphragm 4 into the plating cell 2. Then, the concn. of the copper ions in the plating cell 2 is maintained within the prescribed range in this way.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

①特許出願公開

⑫公開特許公報(A) 平4-74898

®Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成4年(1992)3月10日

C 25 D 21/14

3/38 7/12

7179-4K 6919-4K E

6919-4K

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全5頁)

会発明の名称 鋼めつき装置

> ②特 頤 平2-184990

願 平2(1990)7月12日 後出

資 神奈川県藤沢市藤沢2530番地の238 個発 明 者 上 野

亚 尾 仍発 明 者 和 宏 神奈川県秦野市鶴巻666番地の1、〇-101

栃木県鹿沼市さつき町12-8 東洋技研工業株式会社鹿沼 個発 明 者 LLI. Ш 良 永

事業所内

栃木県鹿沼市さつき町12-8 東洋技研工業株式会社鹿沼 四発 JH 湆 阳 老 市

事業所内

ベルメレツク電極株式 神奈川県藤沢市石川1159番地 勿出 願 人

会社

勿出 願 株式会社アルメツクス , 個代 理 人 弁理士 森 浩之

東京都台東区雷門2丁月19番17号

明

1. 発明の名称

網めっき装置

2. 特許請求の範囲

(t) 被めっき材に餌めっきを行うためのめっき 液を収容しためっき槽と、該めっき槽から循環し た前記めっき液に酮化合物を溶解してめっき液中 の銅イオン濃度を上昇させる溶解槽を含んで成る めっき装置において、前記めっき槽と前記溶解槽 を隣接させたことを特徴とするめっき装置。

(2) めっき用陽極として不溶性金属電極を使用 する請求項1に記載のめっき装置。

(3) めっき棺と溶解棺をめっき液が透過可能な 隔膜で区画した請求項1に記載のめっき装置。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、めっき液中の銅イオンの減少分を遅 滞なく補給してめっき牆内のめっき液の銅イオン 選度をほぼ一定に維持しながら被めっき材の銅め っきを行うためのめっき装置に関する。

(従来技術とその問題点)

両面に網箔層を形成したプリント基板の衰固及 び裏面の回路部分を接続するためには、必要な部 分に貫通孔つまりスルーホールを形成し、欲スル ーホールの内面に飼めっきを施して前記両回路を 接続するようにしている。核スルーホールめっき を行う場合には、前記プリント基板に前記スルー ホールを形成した後、パラジウム含有浴を使用し て活性化を行い、次いで無電解網めっきをプリン ト基板全体に行いめっき薄層を付着させた後、更 に電解網めっきを行うようにする。

無電解めっきのみで全体のめっきを行わずに電 解銅めっきを使用する理由は、第1に無電解網め っきは折出速度が遅く、無電解調めっきのみでは 長時間を要すること、第2に無電解めっき液が高 価であるためである。

不溶性金属電極を使用する電気鋼めっきでは、 めっき処理によりめっき液中の銅イオン濃度が減 少する。減少した場合の銅ィオン締給方法として は次の3種類の方法が知られている。

第1の方法はめっき液に直接網化合物例えば炭酸網を投入し溶解させる方法であり、この方法では前記炭酸網の速やかで均一な溶解を達成できないことが多く、未溶解炭酸網がめっき液中に残留する恐れがある。

第2の方法は粉末の調化合物を水で混錬しスラリとして補給する方法であり、この方法は循環系内つまりめっき槽内への水の持込みがあり水パランスを制御することが難しいという欠点がある。

本発明は、被めっき材への調めっき、特にプリント回路基板等への網めっきを行う際に前述の従来技術の欠点を解消して、水バランスが崩れたり、めっき液の濃度調整が遅れたり、あるいは過大な設置スペースを必要としたりすることのないめっき装置を提供することを目的とする。

(問題点を解決するための手段)

本発明は、被めっき材に飼めっきを行うためのめっき被を収容しためっき槽と、該めっき槽から循環した前記めっき液に調化合物を溶解してめっき液中の開イオン濃度を上昇させる溶解槽を含んで成るめっき装置において、前記めっき槽と前記溶解槽を隣接させたことを特徴とするめっき装置である。

以下本発明を詳細に説明する。

本発明のめっき装置は、被めっき材にめっきを 行うめっき棺と、該めっき槽内のめっき液を循環 させ該めっき液中のめっき網環度を調整する溶解 棺を踏接させたことを特徴とする。

めっき槽と溶解槽とを隣接させるとは両槽を殆

この第3の方法では前述の第1及び第2の方法 における欠点は生じないが、めっき槽とは別に溶 解槽を設けるため独自の設置スペースを必要とし、 更に網イオン調整のためのめっき液の循環をめっ き槽と溶解槽を連結する長い配管を通して行うた め、めっき槽 C 内のめっき液の銅イオンを所定温 度に調整するのに時間を要するとか銅イオン濃度 の変動が大きいという欠点がある。

(発明の目的)

ど間隙を生じさせることなく近接させることを意味し、例えば別個に製造した両槽を互いの側壁が接するよう設置したり、両者をめっき液が透過しない隔壁等を介して一体的に製造したり、あるいは両槽を一体的に製造して両槽をめっき液が透過する隔膜で区面したりする構造が含まれる。

例示した3種類の構造のうち前2者では原槽を連つうち前2者では原間をが必要ではるなるなどでは、両標を記憶が必要でよく、両標を設置であるための設置面積の増大を最小限に抑えることができることができることがは、これらの利点に加えて発力を開かる。 記憶が不要であり未溶解の網化合物のの混入も防止できるという長所がある。

又本発明のめっき装置では絶えず金属化合物の 補給を行う必要はなく、めっき槽内のめっき液中 の銅ィオン濃度を濃度センサにより直接又は間接 的に測定して該濃度が所定値未満に低下したとき にめっき液の溶解槽への循環を行いかつ溶解槽中 のめっき腋に銅化合物を補給し溶解するようにし てもよい。

又陰極は、めっきすべき被めっき材好ましくは プリント回路基板とし、铵プリント回路基板は例 えば合成樹脂上に銅箔を薄く被覆しかつ所定位置 に多数の貫通孔つまりスルーホールを穿設した複 合板である。該被めっき材は、本発明装置により 電解めっきを行う前に該電解めっきを円滑に行う

の誰布膜が最適である。

電流濃度、印加電圧、電流密度、液温等の電解条件自体は従来の電解めっき方法と同様で良く、例えば電流濃度は0.1~3.0 A / & 、印加電圧は1.5~6.0 V 、隔極電流密度は1~10 A / dm²、路極電流密度は1~10 A / dm²、液温は15~35℃程度とする。

次に本発明に係わるめっき装置の一例を添付の 第1図に基づいて説明する。

装置本体1は中央部の箱型のめっき槽2、該めっき槽2の左側壁に一体的に設置されたオーバーフロー槽3、及び前記めっき槽2の右側に未溶解の固体の期化合物を透過させずめっき液のみを透過させる隔膜4を介して前記めっき槽2と一体化された溶解槽5とから成っている。

前記めっき槽2内には、被めっき材(陰極)6 とそれを挟む形で1対の不溶性金属陽極7が配置 され該めっき槽2中のめっき液8は譲めっき槽2 の左壁からオーバーフローして前記オーバーフロ 一槽3に流れ込むようになっている。該オーバー ためにその表面に化学めっきによりめっきする金 属と同じ薄い金属めっき層を形成しておくことが 望ましい。該被めっき材は通常30cm×30cm程度の 板であるが、本発明装置でめっきを行う場合には 一度の操薬で多数の被めっき材を処理できるよう に多数の被めっき材を上下及び左右方向に並べ合 わせて1枚の大きな平板状とし所定の治具で電解 権内に設置することが好ましい。

溶解槽はめっき槽中のめっき液が循環できるよう酸めっき槽に隣接して設置される。酸溶解槽にはめっき液に補給される固体の金属化合物例えば炭酸銅等を溶解槽に添加するための装置を槽に近接して設置しかつ添加された化合物のめっき液への溶解を促進するために撹拌翼を設置することが領ましい。

めっき槽と溶解槽を区画する隔膜を使用する場合の該隔膜は、めっき液のみを透過させ未溶解の金属化合物の透過を抑止できる孔径を有することが望ましく、その材質は特に限定されないが、液透過に対する抵抗損の観点から孔径数μ~十数μ

フロー槽3のめっき被8は該槽3の下方から取り出されて循環ポンプ9により前記溶解槽3に供給され、設溶解槽3のめっき被8の液面が常にめっき槽2のめっき液8の液面より高くなるようにに対する、又前記オーバーフロー槽3の上方には速度センサ10が設置され、設濃度センサ10が設置された網化合物切出装置11に接続されている。なお12は溶解槽5内のめっき液8を攪拌する攪拌買である。

このめっき装置1のめっき被8を循環ボンプ9を使用して循環させながら前記被めっき材6及び不溶性金属隔極7間に過電すると、めっき液8中の銅イオンが還元されて前記被めっき材6の銅めっきが行われる。めっき操作の機械につれてめっき液8中の銅にはかっき操作の機械につれてめっき液8中の銅にはウサ10により測定し該濃度が所定値を下回ったときに前記網化合物の銀化合物を供給する。この銅信をではある。この銅信をではある。この銅信をではある。この銅信をではある。

次に本発明のめっき装置によるめっきの実施例 を記載するが、該実施例は本発明を限定するもの ではない。

実施例

第1図に示すめっき装置を使用し、第1表に示しためっき液を使用して2.5 A/dm² の通電量で被めっき材のめっきを行った。

装置本体の各槽の容量はそれぞれ、めっき槽が 2 ㎡、オーバーフロー槽が0.25㎡、及び溶解槽が 0.5 ㎡となるようにした。又隔膜としては100 μ mの 2 枚の板状フィルク間に10 μ m の板状フィル

(発明の効果)

本発明は、彼めっき材に調めっきを行うためのめっき槽と、該めっき槽から循環した前記めっき 液に網化合物を溶解する溶解槽とを隣接させたことを特徴とするめっき装置である。

従来のめっき槽と将棺を別個に設置しためっき装置では設置スペースの増大と渡度調整達成の時間的遅れが生じるが、本発明装置では、両棺が譲接しているため設置スペースの増大を最小限に抑えることができ、更に溶解槽でめっき液に溶解した調化合物が迅速にめっき槽に捕給されるためのっき液中の減少した調イオンを直ちに補充し、調イオン渡度の変動が小さくなりめっき操作への悪影響を阻止することができる。

更に本発明ではめっき槽と溶解槽を一体化し、 両槽をめっき液を透過させ未溶解の調化合物を透 過させない隔膜で区面するようにしてもよく、こ のような構成を採用すると固体の網化合物がめっ き液中に混入することがなく、しかも両槽を連結 する殆どの配管が不要で、めっき液が溶解槽から

第	1 衰	めっき液組成
Cu*-	18	8 / 2
HzSO4	180	8 / 2
C]-	60	PP [®] / L (酸性硫酸銅めっき用
添加剂	20 m l /	・ m · s · s · s · s · s · s · s · s · s ·

タを挟む構造とし、フィルタが汚染された場合に 内側のフィルタのみを交換するようにした。

前記オーバーフロー槽内のめっき液の鋼イオン 濃度が17.5g/2まで低下したときに濃度センサ により銅化合物切出装置を稼働させ、溶解槽内に 塩基性炭酸鋼粉末を供給した。

競神により塩基性炭酸銅粉末は速やかに溶解した。濃度勾配及び/又はヘッド差圧により該溶液はフィルタを通してめっき槽に移り銅イオン濕度は上昇した。

3 カ月のめっき操作でのめっき液中の飼イオン 濃度の変動は18.2±0.42g/ℓの範囲内に維持された。

同様の測定を第2図に示した従来装置で行った ところ、期イオン諸度の変動範囲は 18.6 ± 0.648 /2であった。

直接めっき槽に補充されるため濃度調整を迅速に 行うことができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明に係わるめっき装置の一例を 示す縦断面図、第2図は、従来のめっき装置の一 例を示す縦断面図である。

1・・・装置本体 2・・・めっき槽

3 ・・・オーパーフロー槽 4 ・・・隔膜

5・・・溶解槽 6・・・被めっき材

7・・・不溶性金属隔極 8・・・めっき液

9・・・循環ポンプ 10・・・濃度センサ

11・・・顕化合物切出装置 12・・・飛斧翼

特許出願人 ペルメレック電極株式会社

同 束详技研工集株式会社

同代理人 弁理士 森 浩

特閒平4-74898 (5)

第 イ 図

